简

激光加热微管靶得到很高的粒子数反转

利用三体复合机制已相继实现了Al+11、Mg+10 离子类氦能级 1s 3p 与 1s 4p 间的粒子数反转[1~8]。 采用的办法是高功率激光脉冲 打 Al 或 Mg 的平面 靶,使之加温并达到完全离化,然后自由膨胀或在自 由膨胀的同时加冷阱使电子温度迅速下降, 以增加 三体复合几率[4]。在自由膨胀的等离子体冕区,电 子温度 T.≈10~100 eV, 电子密度 N.≈1018~1020 cm-3。三体复合占主导地位,而辐射复合在其次。离 靶面约 60~200 µm 处观察到粒子数反转,但反转粒 子数密度不高,相应的增益系数也低。这主要是由 于自由膨胀使得等离子体密度下降造成的。一般的 数据为, N3 与 N4 的密度约在 1012~1014 cm-8(1~3)。 增益0.2~1 cm-1。当激光功率密度较高时,粒子密 度可达 1015 cm-8, 增益达 10 cm-115]。还有, 这些反 转粒子还很难做到分布在同一轴向, 起不到对自发 辐射的行波放大作用。

为了得到高的反转粒子密度,并基本上沿同 方向分布,我们从研究激光与等离子体细丝的相互 作用的过程中,产生了利用激光打微管靶的设想。通 过X光晶体谱仪测定 Mg⁺¹⁰ 的类氦谱,从空间积分 谱与空间分辨谱均判明:不仅在 1s 3p 与 1s 4p 之间 有很高的粒子粒反转与增益,在 1s 3p 与 1s 5p 之间 也发现了很高的反转粒子密度和增益。

将激光聚焦于微形管靶,在管口及管壁产生的 高温等离子体将向管内喷射,管壁本身又起了约束 并冷却等离子体的作用。使得等离子体一直维持在 高密度并沿微管轴方向分布,温度也降低了,这对实 现管轴方向的受激辐射将是有利的。实验是在上海 光机所六路激光装置上进行的,采用六路中的一路, 能量 4~10 J,脉宽 80~250 ps。靶面功率密度 0.6 ~5×10¹⁴ W/cm²,激光频带宽度为 0.02 nm。在沿 激光前进的 # 方向,即靶的后向放置 TIAp 晶体谱 仪 1,在靶的侧向,即 y 轴方向放置 TIAp 晶体谱仪2, 在靶的顶部,即 x 轴方向,放置针孔相机,在反激光 方向取出二次谐波在条纹相机上扫描。靶是在厚

而自然 大斯 世命

180 μ m 的镁箔上用激光打出 ϕ 40~ ϕ 80 μ m 的孔而 作成的。靶的置放位置是在xy面上。

我们得到了镁的类氢类氢的时间空间积分谱的 黑密度描述。比较这些描述可以看出,侧向与后向 的Mg⁺¹⁰ 离子的类氢谱线轮廓是不一样的。由透过 率 T,根据文献[3]的方法可以求出粒子数反转密度 *AN* 和相应的增益系数 g,结果表明:在1s 3p 与 1s4p, 1s 5p 之间均有粒子数反转最高增益 g=17.2 cm⁻¹。、与用同一功率水平的器件打铜作冷阱的镁 靶^{CU}的结果相比,反转粒子密度和增益系数增加了 约 20~30 倍。

为了判明反转粒子密度的空间分布,我们将微 形管做成侧面有开口的微形管,微管内 X 光信息由 开口进入晶体谱仪 3 进行测量,实验结果表明,粒子 反转密度的峰值在管内距管口 120 μm 处。

这些结果已清楚地表明,高功率激光加热微管 靶,使得管口附近产生了大量完全离化的等离子体, 然后这些等离子体有一部分往外自由膨胀,另一部 分向管内喷流,温度下降但密度较高,这样有利于得 到管轴方向分布的粒子数反转。

本课题得到中国科学院自然科学基金资助。

[1] |卢仁祥],毛楚生;《中国科学A辑》,1984,No.6,573.

文 献

- [2] V. A. Bhagavatula; IEEE J. Quant. Electr., 1980, QE-16, 603.
- [3] V. A. Bhagavatula, B. Yaakobi; Opt. Commun., 1978, 24, 331.
- [4] V. A. Boiko et al.; IEEE J. Quant. Electr., 1984, QE-20, 206.
- [5] D. L. Matthews et al.; Phys. Rev. Lett., 1985, 54, 110.

(中国科学院上海光机所 谭维翰 林尊琪 余文炎 顾 敏 陈文华 郑玉霞 王关志 崔季秀 程瑞华 邓锡铭 1987年5月20日收稿)